## بررسی تاثیر حضور STATCOM و HSFCL بر عملکرد رله دیستانس در شبکه انتقال

چکیدہ	اطلاعات مقاله
	نوع مقاله: پژوهشی
در این مقاله، تأثیر نصب محدود کننده جریان خطای ابررسانای هیبریدی HSFCL <sup>،</sup> بر	دریافت مقاله: ۱۴۰۰/۱۲/۱۹
امپدانس ظاهری دیده شده، توسط رله دیستانس در سیستمهای قدرت جبران سازی شده	بازنگری مقاله: ۱۴۰۱/۰۴/۱۱
با STATCOM <sup>۲</sup> بررسی شده است. برای پاسخگویی به افزایش تقاضای برق و افزایش	یذیرش مقاله: ۱۴۰۱/۰۵/۲۹
ظرفیت خط انتقال، STATCOM در سیستم قدرت نصب میشود. نصب STATCOM	
در سیستم قدرت باعث افزایش سطح جریان اتصال کوتاه میشود که برای کنترل این	واژگان کلیدی:
جریان، استفاده از HSFCL پیشنهاد میشود. نصب STATCOM و HSFCL باعث تغییر	رله دیستانس،
اندازه امپدانس محاسبه شده توسط رله دیستانس شده و بر عملکرد سیستم حفاظتی تاثیر	خط انتقال،
می گذارد. محل نصب STATCOM می تواند قبل یا بعد از محل خطا باشد و باید محل و	محدودكننده جريان خطاي
فاصله آن از رله مورد بررسی قرار گیرد، همچنین محل نصب HSFCL که میتواند قبل یا	ابررسانی هیبریدی،
بعد از ترانسفورماتور ولتاژ باشد، عواملی میباشند که بر عملکرد سیستم حفاظتی تاثیر می	.STATCOM
گذارند. نوع خطا، محل وقوع خطا و مقاومت خطا پارامترهای دیگری هستند که در مطالعات	
شبیه سازی، در نظر گرفته شده و بررسی شده است. HSFCL دارای دو ساختار	
RHSFCL و LHSFCL مىباشد كه هر دو ساختار بررسى شده و دو حالت باهم مقايسه	
شده است. سیستم مورد نظر با تجهیزات ذکر شده در نرم افزار PSCAD / EMTDC	
مدل سازی شده و نتایج مورد بحث قرار گرفته است.	

زهرا مروج<sup>۱،\*</sup>، علیرضا جدائی<sup>۲</sup>، محمد پازکی<sup>۳</sup>

### ۱–مقدمه

در سالهای اخیر صنعتی شدن و شیوه زندگی شهرنشینی باعث افزایش چشمگیر تقاضای برق شده است. با افزودن تجهیزات جدید مانند ادوات FACTS (سیستم انتقال انعطاف پذیر) میتوان ظرفیت خط انتقال را افزایش داد [۱]. ادوات FACTS مانند STATCOM معمولا به عنوان یک راه حل موثر برای پاسخ سریع به تغییرات ولتاژ و توان راکتیو در شرایط عادی و خطادار در نظر گرفته میشود [۲ و ۳]. نصب STATCOM در شبکه و همچنین تلاش برای پاسخگویی به رشد تقاضای برق و افزایش منابع تولید پراکنده منجر به بالا رفتن سطح جریان اتصال کوتاه در

سیستم انرژی شده است. خطاهای اتصال کوتاه شایعترین خرابی است که در سیستمهای قدرت رخ می دهد و منجر به گرمای بیش از حد در تجهیزات سیستم برق از قبیل ژنراتورها، ترانسفورماتورها، هادیها و غیره می شود. برای جلوگیری از نقص و خرابی، باید ظرفیتی اضافی در طراحی تجهیزات در نظر گرفته شود تا اتصال کوتاه به تجهیزات آسیب نرساند، که به سهم خود هزینهها را به صورت چشمگیری افزایش می دهد. از طرف دیگر، سهم برخی تجهیزات در حین وقوع خطای اتصال کوتاه باعث افزایش جریان خطا می شود [۴ و ۵]. این امر منجر به تأثیرات منفی مانند عملکرد ناموفق قطع کننده مدار و فشارهای

<sup>\*</sup>پست الكترونيك نويسنده مسئول: zmoravej@semnan.ac.ir

۱. استاد، دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه سمنان

۲. دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، دانشگاه سمنان

۳. دانشیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه دامغان

مکانیکی و الکتریکی بر روی تجهیزات سیستم قدرت می شود. برای کاهش جریان خطا، تاکنون رویکردهای مختلفی معرفی شده است. استفاده از فیوزهای قابلیت قطع بالا، ترانسفور ماتور با امپدانس اتصال کوتاه بالا، راکتورهای سری و تغییر پیکربندی شبکههای برق از روشهای معمول است. با این حال، رویکردهای فوق الذکر برای تحقق کلیه الزامات ناتوان است. برخی از آنها گران هستند و برخی دیگر از نظر فنی برای اعمال در ولتاژهای مختلف قابل توجیه نیستند [7]. تجهیز سیستم برق با محدود کنندههای جریان خطا ۵ (FCL) یک راهحل جایگزین و موثر برای کاهش سطح اتصال كوتاه است. FCL در شرايط عادى افت ولتار كمي دارد، اما جریان خطا را در چند میلی ثانیه پس از بروز خطا در سیستم قدرت محدود می کند [۶و۷]. با قرار دادن FCL در مکانهای مناسب، میتوان هماهنگی بین تجهیزات حفاظتی سیستمهای قدرت دارای منابع تولید پراکنده را، بازگرداند. ساختارهای مختلفی برای توسعه FCL پیشنهاد شده است که می توان این ساختارها را به دو دسته: FCL ابررسانا '(SFCL) و FCL غير ابررسانا '(NSFCL) تقسيم کړد.

با این حال، پیشرفتهای اخیر در مواد ابررسانا، SFCL را به عنوان یک وسیله امیدوارکننده برای محدود کردن جریان خطا مطرح کرده است. علاوه بر این، عملکرد فنی SFCL قبلا با آزمایش میدانی تأیید شده است. به طور کلی، الزامات محدود کنندههای جریان خطای ایدهآل به شرح زیر است: اتلاف توان کم در حالت عادی، افت ولتاژ کم در طول شرایط عادی، توانایی محدود کردن جریان خطا به صورت مناسب، امکان مقاومت در برابر جریان خطا، عملکرد تجهیزات حفاظتی به صورت مناسب، زمان پاسخ سريع، زمان بازيابي كوتاه، قابليت انجام عمليات چندگانه بدون مداخله انسانی و ... [۶]. تاکنون ایدههای مختلفی برای توسعه SFCL ارائه شده است. با این حال، به دلایل فنی و اقتصادی، سرمایه گذاران فناوری بیشتر بر روی نوع SFCL ، (RSFCL)<sup>^</sup> مقاومتی SFCL ، (RSFCL) SFCL هسته آهن اشباع '(SISFCL) متمركز شدهاند. در میان محدود کنندههای جریان خطا ابررسانا مختلف، نوع هیبریدی کاربرد بیشتری دارد. در نوع هیبریدی اندازه مواد ابررسانا نسبت به نوع مقاومتی، کمتر میباشد، بنابراین زمان بازیابی عنصر ابررسانا اندک خواهد بود و می تواند به صورت سريع آماده عملكرد دوباره شود. علاوه بر اين، از نظر

اقتصادی نیز مناسب خواهد بود. در HSFCL، از المان ابررسانا ''(HTS) فقط برای شناسایی جریان خطا و به منظور جابجایی جریان خطا در سیم پیچ محرک استفاده میشود و از بخش محدود ساز جریان ''(CLP) برای کاهش جریان خطا استفاده میشود [۹]. بررسیهای موجود در [۱۰] نشان میدهد که از محدود کننده جریان خطای هیبریدی میتوان در سیستمهای توزیع و انتقال استفاده کرد.

به کارگیری STATCOM و HSFCL در شبکه برق دارای مزایای میباشد که به آن اشاره شد اما استفاده این تجهیزات در شبکه برق بدون بررسی دقیق همه جوانب این تجهیزات امکان ایجاد تاثیرات منفی در شبکه برق را افزایش می دهد [۸].

در رابطه با این موضوع چندین مقاله منتشر شده است: در [۱۱] تاثیر نصب SFCL بر رله دیستانس بحث شده است. علاوه بر مشکل محل PT، بی توجهی به تأثیر مقاومت خطا در هنگام ارزیابی و عدم وجود مطالعات تحلیلی برای تایید آنالیز، از معایب این مقاله میباشد. اصل عملکرد HSFCL با SISFCL کاملا متفاوت است، اما در [۱۲] از نتایچ به دست آمده در رابطه با تأثیر HSFCL بر روی رله دیستانس برای بررسی SISFCL استفاده شده است که روش مناسبی نمی باشد.

در [۱۳]، تأثیر SFCL از نوع پل دیودی بر عملکرد رله دیستانس با روشهای تحلیلی و شبیه سازی ارزیابی شده است، اما از معايب اين مقاله مي توان به استفاده از روابط ریاضی پیچیده برای تجزیه و تحلیل و عدم بررسی موقعیت نصب SFCL اشاره کرد. نویسندگان در [۱۴] تأثیر نصب SISFCL بر رله دیستانس را بررسی کرده و یک راه حل برای بهبود اثرات جانبی آن ارائه میدهند. اما، علاوه بر مشكل محل نصب اين محدود كننده جريان خطا، غفلت از تاثير مقاومت خطا در هنگام ارزيابي، نقطه ضعف اين مقاله میباشد. در [۱۵]، یک طرح تطبیقی برای بهبود دقت رله دیستانس در حضور HSFCL ارائه شده است. با این حال، روش پیشنهادی از اطلاعات عملکرد SFCL استفاده می کند و برای تصمیم گیری دقیق به سخت افزار اضافی احتياج دارد. علاوه بر اين، فقط يک مطالعه شبيه سازي در نظر گرفته شد که منجر به پنهان کردن مواردی مانند تأثیر پارامترهای HSFCL و نوع خطا می شود. در [۱۶]، یک طرح برای تغییر تنظیمات رله و تغییر ناحیه های حفاظتی

بر اساس وضعیت SFCL پیشنهاد شده است، در این مقاله با در نظر گرفتن شرایط دستور قطع آنی و دستور قطع با تاخیر، از روش تنظیمات گروهی<sup>۱۱</sup>(GSs) ناحیههای حفاظتی استفاده شده است. در [۱۷] عملکرد رله دیستانس را در خطوط انتقال جبران شده توسط ادوات FACTS مطالعه شده است. در [۱۸] مطالعه اثر STATCOM بر رله دیستانس یک سیستم قدرت با تجزیه و تحلیل فركانسي ارائه شده و ثابت شده است كه توان راكتيو تزريق شده توسط STATCOM، امپدانس ظاهری دیده شده توسط رله را تحت تاثیر قرار میدهد. یک طرح حفاظت دیستانس تطبیقی در [۱۹] برای بهبود عملکرد طرح حفاظت دیستانس مرسوم برای خطوط جبران سازی شده با خطاهای مقاومت بالا ارائه شده است. در [۲۰] اینورتر استفاده شده در سیستم فتوولتائیک به عنوان جبران کننده STATCOM نیز مورد استفاده قرار گرفته و تاثیر این موضوع بر عملکرد حفاظت دیستانس بررسی شده است. در [۲۱] تجزیه و تحلیل یک تکنیک هماهنگی محدود کننده جریان خطا ابررسانای نوع مقاومتی (RSFCL) و جبران کننده STATCOM را برای بهبود پایداری گذرا سیستم قدرت ارائه می کند. نقش اصلی این مدل تر کیبی محدود كردن جريان خطابا استفاده از فناورى ابررسانا و پشتيباني موثر توان راكتيو با استفاده از STATCOM است. در [۲۲] یک مشخصه تطبیقی برای از بین بردن اثرات نامطلوب مقاومت خطا و جبران كننده STATCOM بر عملکرد رله دیستانس در خط انتقال مورد بررسی قرار گرفته است. نصب STATCOM در سیستم باعث افزایش سطح جریان خطا می شود که با نصب HSFCL می توان تا حدودی این افزایش سطح جریان را کنترل کرد. اما نصب STATCOM و HSFCL بر عملكرد رله ديستانس تاثير می گذارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

در این مقاله ساختار STATCOM و HSFCL، عملکرد هر یک و تاثیر نصب این دو بر عملکرد رله دیستانس بررسی شده و شرایط مختلف مورد بحث قرار گرفته است. RHSFCL و LHSFCL ساختارهای مختلفی از HSFCL میباشد که عملکرد هر یک در محدود کنندگی بعد از TT نصب کرد که هر دو حالت بر عملکرد رله بعد از STATCOM و محل دصله بین STATCOM و محل وقوع خطا، محل نصب STATCOM و تنظیمات آن،

عوامل دیگری میباشد که بر عملکرد رله دیستانس تاثیر گذار بوده و در این مقاله بحث شده است. مقاومت خطا و نوع خطا نیز پارامترهایی هستند که بر عملکرد رله دیستانس در حضور STATCOM و HSFCL تاثیر می گذارند و در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

۲-ساختار و عملکرد HSFCL و STATCOM و STATCOM و STATCOMدر این بخش ابتدا ساختار HSFCL و رفتار آن هنگام وقوعخطا بررسی شده، سپس ساختار و عملکرد STATCOMمورد بحث قرار گرفته است [۳۲ و ۲۴ ].

## HSFCL-1-7

همه ی محدود کنندههای جریان خطا دارای یک وظیفه مشترک هستند و باید جریان خطا را به محض ظاهر شدن در سیستم قدرت، محدود کنند اما هر یک از محدود کنندههای جریان دارای ساختار و اجزای مختلفی می باشد[۱۰و۲۵]. در این قسمت ساختار HSFCL به صورت کامل شرح داده می شود.

شکل (۱) ساختار ساده HSFCL را نشان میدهد [۱۰]. المان ابررسانا، بخش محدودساز جریان و کلید قدرت (CB) بخشهای اصلی آن را تشکیل میدهد. در شرایط عادی اگر سیستم ایدهآل در نظر گرفته شود، المان ابررسانا مقاومت ناچیزی در مقابل عبور جریان بار دارد و با سری شدن با کلید قدرت مسیر بدون محدودیتی برای عبور جریان بار فراهم می کند و هیچ جریانی از شاخه موازی عبور نمی کند، اما در عمل بخش کوچکی از جریان بار از شاخه موازی عبور می کند. هنگامی که خطایی در سیستم قدرت رخ میدهد، المان ابررسانا خاموش میشود و مقاومتش به سرعت شروع بیدا می کند، سپس جریان خطا به طور کامل به شاخه موازی منتقل میشود و ابررسانا وارد مرحله بازیابی میشود [۲۲ و ۲۲].



شکل ۱- مدل مداری HSFCL

همچنین رفتار مقاومتی المان ابررسانا ثابت نبوده و در زمان های مختلف دارای مقدار مختلفی میباشد که در شکل (۲) قابل مشاهده میباشد[۱۰].

رابطه (۱) مشخصه رفتار المان ابررسانا در زمانهای مختلف را نمایش میدهد که این مشخصه به صورت تجربی به دست آمده است:



HTS به در آن  $t_0$   $t_1$   $t_0$   $t_1$   $t_2$   $t_1$   $t_0$   $t_0$  زمان حذف شدن  $t_2$  و  $t_1$  به ترتیب لحظه خاموش شدن MTS زمان حذف شدن خطا از بخش HTS یا زمان شروع اولین مرحله بازیابی HTS میباشند،  $R_n$  حداکثر مقاومت HTS بعد از خاموش شدن،  $T_F$  میاشند،  $\pi_r$  محداکثر مقاومت  $\alpha_1$  ،  $\alpha_2$   $\alpha_1$  ، HTS مقدار شیب منفی کاهش مقاومت در دو مرحله بازیابی و  $t_2$ ،  $t_1$ ،  $t_2$ ,  $t_1$  میباشند.

رابطه (۱) را می توان به صورت رابطه (۲) بازنویسی کرد تا مقدار امپدانس کل HSFCL به دست آید:

$$Z_{HSFCL} = \begin{cases} 0 & t < t_0 \\ \mathbf{R}_{HTS}(t) \mathbf{PZ}_{CLP} & t_0 \le t < t_{CB} \\ Z_{CLP}(\mathbf{R}_{CLP} or X_{CLP}) & t \ge t_{CB} \end{cases}$$
(Y)

همانطور که از رابطه (۲) مشخص است محدود ساز جریان دارای امپدانس مشخصی نمیباشد و بر اساس زمان متغیر میباشد. امپدانس شاخه محدودساز جریان را میتوان به صورت مقاومتی  $(R_{CLP})$ یا به صورت اندوکتانسی  $(X_{CLP})$ پیاده سازی کرد که در این مقاله هر دو حالت مورد بررسی قرار گرفته است. اصول عملکرد FCL مبتنی بر وارد کردن یک امپدانس هنگام وقوع خطا میباشد، بنابراین میتوان بیان کرد که افت ولتاژ دو سر FCL با جریان عبوری از آن رابطه مستقیم دارد که با در نظر گرفتن این امر میتوان رابطه (۳) را بیان کرد:

$$V_{HSFCL} = Z_{HSFCL}I$$

STATCOM-۲-۲

(٣)

FACTS نوعی از ادوات FACTS است که به صورت موازی به سیستم وصل میشود. STATCOM ولتاژ و فاز مورد نظر تبدیل می کند. به عبارت دیگر، ولتاژ خروجی و فاز مورد نظر تبدیل می کند. به عبارت دیگر، ولتاژ خروجی اینورتر باید در شرایط همگام با ولتاژ سیستم تحت هر شرایطی باشد . شماتیک کلی STATCOM در شکل (۳) شرایطی باشد . شماتیک کلی STATCOM در شکل (۳) نشان داده شده است. در NATCOM وقتی دامنه ولتاژ نشان داده شده است. در اید (۷<sub>a</sub>c) بیشتر میباشد جریان (Ish) از مبدل به سیستم ( $x_{ac}$ ) بیشتر میباشد جریان STATCOM توان راکتیو تولید می کند، اگر دامنه ولتاژ (Ish) از سیستم AC ترریق میشود و خروجی ( $v_{a}$ ) از ولتاژ سیستم ( $v_{ac}$ ) کمتر باشد جریان (Ish) ولتاژ شیستم ( $v_{ac}$ ) کمتر باشد جریان (Ish) ولتاژ شیستم ( $v_{ac}$ ) کمتر باشد دران زریق میشود و زراد (Ish) ولتاژ سیستم ( $v_{ac}$ ) کمتر باشد در از (Ish) ولتاژ شیستم ( $v_{ac}$ ) کمتر باشد در از دامنه ولتاژ دامنه (Ish) ولتاژ سیستم (Ish) می میشود و ولتاژ خروجی با ولتاژ سیستم برابر باشد، مقدار تولید یا



شكل ٣- STATCOM به صورت منبع ولتاژ [٢٨]

## ۳-تاثیر HSFCL و STATCOM بر رله دیستانس

محل نصب HSFCL و STATCOM عاملی است که بر امپدانس اندازه گیری شده توسط رله دیستانس تاثیر میگذارد. دو مکان ممکن برای نصب HSFCL و دو حالت ممکن برای نصب STATCOM امکان پذیر میباشد که در شکل (۴-الف) قابل مشاهده میباشد. مکان نصب HSFCL را میتوان قبل و بعد از PT در نظر گرفت، همچنین مکان ممکن برای نصب STATCOM میتوان بین محل خطا و رله دیستانس یا محل خطا و باس دور باشد.

رابطه (۴) به ترتیب روند محاسبه امپدانس دیده شده توسط رلههای دیستانس را بیان میکند [۱۰].

$$\frac{V_{i}^{(1)} - \alpha V_{i}^{(2)}}{I_{j}^{(1)} - \alpha I_{j}^{(2)}} = \frac{V_{i}^{(A)} - V_{i}^{(B)}}{I_{j}^{(A)} - I_{j}^{(B)}}$$

$$\frac{I_{i}^{(1)} - \alpha I_{i}^{(2)}}{I_{j}^{(1)} - \alpha I_{j}^{(2)}} = \frac{I_{i}^{(A)} - I_{i}^{(B)}}{I_{j}^{(A)} - I_{j}^{(B)}}$$

$$\alpha = 1 R 120^{\circ}$$
(\.)

همچنین با جمع بندی روابط و با توجه به شکل (۴-ج) میتوان مقدار  $Z_{M(A-B)}$  به صورت رابطه (۱۱) به دست آورد:

$$Z_{M(A-B)} = x Z_{L}^{(1)} + R_{F} \frac{I_{F}^{A} - I_{F}^{B}}{1 \frac{A}{2} \frac{A}{2} \frac{I_{B}^{A}}{4} \frac{I_{B}^{B}}{4} \frac{I_{B}^{B}}{4} \frac{I_{B}^{A}}{4} \frac{I_{B}^{B}}{4} \frac{I_{B}^{A}}{4} \frac{I_{B}^{B}}{4} \frac{I_{B}^{A}}{4} \frac{I_{B}^{A}}{4$$

مقدار متناسب متغییر d در شکل (۴-الف) نشان داده شده است. روابط (۹) و (۱۱) نشان دهنده امپدانس اندازه گیری شده توسط رله دیستانس برای خطاهای مختلف در حضور HSFCL و STATCOM میباشند. این امپدانسها دارای چهار مولفه به شرح زیر میباشند:

اولین مولفه  $(\Delta Z_{Actual})$  مربوط به مقدار امپدانس توالی مثبت خط انتقال از نقطه نصب رله تا محل وقوع خطا میباشد. این مولفه تاثیر پذیر از امپدانس خط بوده و از تجهیزات HSFCL و STATCOM تاثیر نمی گیرد، بنابراین حضور این تجهیزات یا مکان نصب این تجهیزات تاثیری بر مقدار این مولفه ندارد.

دومین مولفه  $(\Delta Z_{R_F})$  تغییرات امپدانس ایجاد شده ناشی از مقاومت خطا را نشان میدهد. علاوه بر مقدار مقاومت خطا، جریان باسهای دور و نزدیک، بر این مولفه اثر میگذارند. همچنین در شرایط یکسان میزان امپدانس اضافه شده ناشی از این مولفه قبل و بعد از نصب تجهیزات اضافه شده ناشی از این مولفه قبل و بعد از نصب تجهیزات STATCOM و STATCOM یکسان نیست زیرا با نصب این تجهیزات جریان عبوری از مقاومت خطا تغییر میکند که نتیجه آن تغییر افت ولتاژ دو سر مقاومت خطا و در نتیجه تغییر امپدانس ظاهری دیده شده توسط رله دیستانس میباشد. سومین مولفه  $(\Delta Z_{HSFCL})$  اثر مستقیم HSFCL میباشد. سومین مولفه ( $\Delta Z_{HSFCL}$ ) اثر مستقیم دانس بر امپدانس ظاهری دیده شده توسط رله دیستانس را نشان میدهد. مقدار این امپدانس به ولتاژ دو سر محدود کننده در فازی که خطا رخ داده، وابسته است.

$$Z_{m(Q-G)} = \frac{V_{\text{Relay}}}{I_{\text{Relay}}} = \frac{V_Q}{I_Q + KI_0}$$

$$Z_{m(Q-Q)} = \frac{V_{\text{Relay}}}{I_{\text{Relay}}} = \frac{V_{Q-Q}}{I_{Q-Q}}$$

$$K = \frac{Z_L^{(0)} - Z_L^{(1)}}{Z_I^{(1)}}$$
(f)

که در آن Q نشان دهنده فازهای  $I_0$ , c.b.a  $I_0$  جریان توالی مفر،  $I_L^{(0)}$ ,  $Z_L^{(0)}$ ,  $Z_L^{(1)}$ , مفر،  $I_{Rela}$ ,  $I_{Rela}$  مفر، K ضریب جبرانسازی توالی صفر و  $V_{Rela}$ ,  $V_{Rela}$  ولتاژ و جریان مناسب برای تحریک رله میباشد [۳۰]. فرض میشود که HSFCL بعد از PT و STATCOM بین خطا و رله به سیستم متصل شده باشد. در رابطه (۴) از توالی مثبت و صفر استفاده شده است، برای به دست آوردن این توالیها در شکل (۴–ب) قانون KVL اعمال میشود. که در نهایت رابطه (۵) حصل می شود. که در نهایت رابطه (۵) حاصل می شود.

$$\begin{split} V_{M}^{(1)} = & V_{HSFCL}^{(1)} + Z_{L1}^{(1)} I_{L}^{(1)} + Z_{L2}^{(1)} (I_{L}^{(1)} + I_{sh}^{(1)}) + R_{f} I_{f}^{(1)} \\ V_{M}^{(0)} = & V_{HSFCL}^{(0)} + Z_{L1}^{(0)} I_{L}^{(0)} + Z_{L2}^{(0)} (I_{L}^{(0)} + I_{sh}^{(0)}) + R_{f} I_{f}^{(0)} \\ V_{M}^{(2)} = & V_{HSFCL}^{(2)} + Z_{L1}^{(2)} I_{L}^{(2)} + Z_{L2}^{(2)} (I_{L}^{(2)} + I_{sh}^{(2)}) + R_{f} I_{f}^{(2)} \end{split}$$

همچنین روابط (۶)، (۷) و (۸) در [۹] اثبات شده است.

$$V_{M}^{A} = V_{M}^{(1)} + V_{M}^{(2)} + V_{M}^{(0)}$$

$$V_{HSFCL}^{A} = V_{HSFCL}^{(1)} + V_{HSFCL}^{(2)} + V_{HSFCL}^{(0)}$$
( $\mathcal{F}$ )

$$I_{M}^{A} = I_{M}^{(1)} + I_{M}^{(2)} + I_{M}^{(0)}$$
  

$$I_{F}^{A} = I_{F}^{(1)} + I_{F}^{(2)} + I_{F}^{(0)} = 3I_{F}^{(1)}$$
(Y)

$$Z_{L}^{(1)} = Z_{L}^{(2)}$$

$$Z_{L1} = x (1-d) Z_{L}$$

$$Z_{L2} = x dZ_{L}$$
(A)

(۹) با جمع بندی روابط (۴) تا (۸)، برای 
$$Z_{M(A-G)}$$
 رابطه (۹) به دست می آید.

$$Z_{M(A-G)} = XZ_{L}^{(1)} + \frac{R_{F}I_{F}}{I_{M}^{A} + KI_{M}^{0}} + \frac{V_{HSFCL}^{(A)}}{I_{M}^{A} + KI_{M}^{0}} + \frac{V_{HSFCL}^{(A)}}{I_{M}^{A} + KI_{M}^{0}} + \frac{I_{M}^{A} + KI_{M}^{0}}{I_{M}^{A} + KI_{M}^{0}} + \frac{I_{M}^{(1)}I_{sh}^{A} + (Z_{L}^{0} - Z_{L}^{1})I_{sh}^{0}}{I_{M}^{A} + KI_{M}^{0}} + \frac{I_{M}^{A} + KI_{M}^{0}}{I_{M}^{A} + KI_{M}^{0}} + \frac{I_{M}^{A} + KI_{M}^{0} + I_{M}^{A} + I_{M}^{A} + KI_{M}^{0} + I_{M}^{A} + I_{M}^{A} + KI_{M}^{0} + I_{M}^{A} + I$$

با توجه به مبانی مولفههای متقارن رابطه (۱۰) هم معتبر میباشد.



شکل ۴-الف: سیستم مورد مطالعه متصل به HSFCL و STATCOM، ب: دیاگرام تک خطی سیستم مورد مطالعه برای خطای تکفاز، ج: دیاگرام تک خطی سیستم مورد مطالعه برای خطای دوفاز

با در نظر گرفتن (۳) می توان نتیجه گرفت که مقدار این مولفه به امپدانس HSFCL وابسته است، امپدانس HSFCL هم وابسته به تکنولوژی ساخت محدود کننده جریان می باشد. اما موضوع دیگری که باید مورد نظر قرار گیرد مکان نصب HSFCL می باشد. زمانی که HSFCL قبل از TT نصب می شود، افت ولتاژ دو سر HSFCL بر رله دیستانس تاثیر نمی گذارد و این مولفه از مقدار امپدانس اندازه گیری شده توسط رله حذف می شود.

چهارمین مولفه این رابطه  $(\Delta Z_{STATCOM})$ اثر مستقیم چهارمین مولفه این رابطه  $(\Delta Z_{STATCOM})$  بر امپدانس ظاهری دیده شده توسط رله دیستانس را به نمایش می گذارد. مقدار این مولفه به جریان تزریقی توسط جبرانساز و همچنین محل نصب TATCOM مرتبط است. با تغییر محل نصب STATCOM مرتبط است. با تغییر محل نصب Isu مولفه تغییر پیدا می کند. اما اگر نصب STATCOM STATCOM در حلقه بین این مولفه تغییر پیدا می کند. اما اگر نصب STATCOM در حلقه بین این مولفه مقدار این شرایط در حلقه بین این مولفه مقدار این شرایط در حلقه بین تولفه صفر خواهد بود و تاثیری مستقیم بر امپدانس اندازه STATCOM کیری شده نخواهد داشت، در این شرایط در حلقه بین این مولفه مفدار این ترایم مستقیم بر امپدانس اندازه مولفه مفر خواهد دو تاثیری مستقیم بر امپدانس اندازه تاثیر غیر مستقیم بر مقدار جریان N خواهد داشت که با توجه به تاثیر کم این مولفه در محاسبه امپدانس مورد نظر، توجه به تاثیر کم این مولفه در محاسبه امپدانس مورد نظر، این مقدار قابل چشم پوشی می باشد.

شد	سازى	پيادە	سيستم	اطلاعات	جدول(۱) :
----	------	-------	-------	---------	-----------

Ем	$230kV \angle 10^{\circ}$
E <sub>N</sub>	$230kV \angle 0^{\circ}$
طول خط	100 <i>km</i>
فركانس	60 <i>Hz</i>
امپدانس E <sub>M</sub>	$Z_{11} = 0/238 + j5/72\Omega$ $Z_{10} = 2/738 + j10\Omega$
$\mathrm{E}_{\mathrm{N}}$ امپدانس	$Z_{11} = 0/238 + j 6/19\Omega$ $Z_{10} = 0/833 + j 5/12\Omega$
امپدانس خط	$R_0 = 0/275\Omega, L_0 = 3/725mH$ $R_1 = 0/0275\Omega, L_1 = 1/345mH$ $C_1 = 9/483nF, C_0 = 6/711nF$
مقدار المان ابررسانا	$T_{F} = 0/01s, a_{1} = -80s^{-1},$ $a_{2} = -160s^{-1}$ $R_{n} = b_{1} = 2*b_{2} = 10\Omega,$ $X_{CLP} = 8/6\Omega, R_{CLP} = 13/5\Omega$
STATCOM	100MVAR

سیستم شکل (۴) در PSCAD / EMTDC شبیه سازی شده و حالتهای مختلف از نظر مکان قرار گیری المانها مورد بررسی قرار گرفته است. اطلاعات شبکه شبیه سازی شده در جدول ۱ ذکر شده است[۱۰].

# ۲-۴- تاثیر STATCOM و HSFCL بر اندازهجریان خطا

شکل (۵) جریان عبوری از رله هنگامی که خطای تکفاز در سیستم رخ میدهد را برای حالتهای ممکن ساخت HSFCL و تاثیر نصب STATCOM نشان میدهد. در این شکل اگر امپدانس شاخه محدود کننده جریان خطا به صورت مقاومتی پیاده سازی شود RHSFCL نامگذاری شده و در صورتی که این شاخه به صورت اندوکتانسی پیاده سازی شود. LHSFCL نامگذاری می شود.

از شکل (۵) می توان نتیجه گرفت که تجهیز سیستم به STATCOM باعث افزایش سطح جریان اتصال کوتاه می شود که با خط بنفش در این شکل نشان داده شده است. همچنین عملکرد دو نوع محدود کننده در حالت ماندگار یکسان می باشد، اما در سیکلهای اولیه عملکرد RHSFCL بهتر بوده و جریان خطا را بهتر محدود می کند. را به طور موثرتری محدود می کند از طرفی با توجه به در واقع محدود کننده جریان خطای مقاومتی مولفه DC را به طور موثرتری محدود می کند از طرفی با توجه به را به طور موثرتری محدود می کند از طرفی با توجه به دا انتقال جریان به شاخه ی موازی، سلف با تغییرات جریان مخالفت کرده و باعث ایجاد اضافه ولتاژی در دو سر محدود کننده می شود. در نتیجه باعث کاهش جریان و بروز اغتشاشات می شود. در ادامه مقاله حالت RHSFCL را در نظر گرفته و شرایط مورد بررسی قرار می گیرد.

نظر گرفته و شرایط مورد بررسی قرار می گیرد. ۲-۴- تاثیر مکان نصب HSFCL بر محاسبه امپدانس اندازه گیری شده توسط رله دیستانس شکل (۶) تاثیر نصب HSFCL را قبل و بعد از PT در حضور STATCOM به نمایش می گذارد. در شکل (۶) HSFCL بعد از PT با خط قرمز و نصب HSFCL (۶) قبل از PT با خط زرد، برای خطای تک فاز با شرایط نصب ۶۰ km را جا مخط و وقوع خطا در km خط، نمایش داده شده است. قابل مشاهده است که با نصب HSFCL بعد از PT مقدار امیدانس دیده شده افزایش

می یابد و سیر خط امپدانسی به سمت بالا انتقال داده



شکل ۵- جریان اتصال کوتاه عبوری برای سه حالت: قبل از نصب HSFCL، بعد از نصب RHSFCL وLHSFCL



۴–۳ امپدانس اندازه گیری شده توسط رله دیستانس در شرایط مختلف

شكلهای (۷) تا (۱۲) نتایج شبیه سازی را در حالتهای مختلف نشان میدهد. در این شكلها خط بنفش حالتی را نشان میدهد كه در سیستم STATCOM و HSFCL نصب باشند. خط زرد حالتی را نشان میدهد كه فقط HSFCL در سیستم نصب شود و MSFCL در سیستم نصب شده و از HSFCL استفاده نشود. خط قرمز نشان دهنده عملكرد رله دیستانس بدون حضور MSFCL و HSFCL می باشد.

در شکل(۲) نتیجه حالتی را به نمایش میگذارد که STATCOM در ۴۰km باس M نصب شده و خطا در ۸۰km باس M رخ داده است. شکل (۸) حالتی را نشان می دهد که STATCOM در ۴۰km باس M نصب شود

و خطا در ۵۰km باس M رخ دهد. شکل (۹) حالتی را نشان می دهد که STATCOM در ۲۰km باس M نصب شود و خطا در ۳۰km باس M رخ دهد. در شبیه سازی شکلهای (۷) تا (۹) مقاومت خطا بسیار ناچیز و نزدیک به صفر فرض شده است. شکل (۱۰) مقادیر مختلف مقاومت خطا را برای حالتی که STATCOM و HSFCL در شبکه نصب باشند را به نمایش می گذارد. در این حالت با افزایش مقدار مقاومت خطا سیر خط امیدانس به بالا انتقال داده می شود که در نهایت وقوع خطا در مقدار مقاومت ۴۵ اهم را سیستم حفاظتی تشخیص نداده است. دلیل جابهجایی عمودی سیر خط امپدانسی، نصب STATCOM مى باشد كه راكتانس امپدانس محاسبه شده را نیز تحت تاثیر قرار میدهد. شکل (۱۲) خطای دو فاز AB را برای حالتی که STATCOM در ۳۰km از باس M نصب شده و خطا در ۶۰km از باس M رخ دهد، به نمایش گذاشته است. در این شکل قابل مشاهده است که با افزایش فاصله نصب STATCOM و افزایش فاصله محل خطا مقدار امپدانس محاسبه شده، افزایش یافته است. با مقایسه شکلهای (۷) تا (۱۰) برای خطای تکفاز و شکلهای (۱۱) و (۱۲) برای خطای دو فاز تاثیر نصب HSFCL و STATCOM بر شبکه قابل مشاهده می باشد. همانطور که در معادلات (۹) و (۱۱) نمایش داده شده است، اضافه كردن اين تجهيزات باعث اضافه شدن مقدار امپدانس محاسبه شده می شود که مقدار این امیدانس وابسته به محل خطا و محل نصب STATCOM می باشد که در حالتها و مکانهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.



شكل (۱۰): فاصله نصب STATCOM از رله ۲۰km و فاصله





شکل(۱۱) : فاصله نصب STATCOM از رله ۲۰km و فاصله وقوع خطا از رله ۶۰km



ع ۲۰۱۰ فاصله نصب ۶۰۲۳۲۰۲۵۱۱ رکه ۲۰۳۳ و فاصا وقوع خطا از رکه ۶۰km



شكل ۲- فاصله نصب STATCOM از رله ۴۰km و فاصله

وقوع خطا از رله ۸۰km



شکل ۸- فاصله نصب STATCOM از رله ۴۰km و فاصله وقوع خطا از رله ۵۰km



وقوع خطا از رله ۳۰km

۴-۴ امپدانس اندازه گیری شده در مدهای کاری مختلف STATCOM

در شکل (۱۳) حالتهای مختلف تنظیم STATCOM و تاثیر این تنظیمات بر روی رله دیستانس قابل مشاهده هست در این شکل  $V_{ref} = 1.05$  حالت خازنی STATCOM را نشان میدهد و STATCOM را نشان میدهد. سلفی STATCOM را نمایش میدهد.



جریان  $_{st}$  *T*زریق می کند بنابراین مقدار مولفه چهارم معادلات (۹) و (۱۱) مثبت خواهد بود که باعث اضافه شدن مقدار امپدانس محاسبه رله دیستانس می شود که این حالت با خط بنفش در شکل (۱۳) نمایش داده شده است، اما زمانی که STATCOM می باشد STATCOM از شبکه جریان می کشد (جهت جریان بر عکس شده)، یا به عبارت دیگر مقدار مولفه چهارم معادلات (۹) و (۱۱) منفی می باشد که باعث کم شدن مقدار امپدانس محاسبه رله دیستانس می شود که این حالت با خط زرد در شکل (۱۳) نمایش داده شده است.

جدول ۲ امپدانس نهایی اندازه گیری شده توسط رله دیستانس در شرایط مختلف و درصد تغییرات امپدانس اندازه گیری شده با نصب HSFCL و STATCOM را نشان می دهد. همانطور که در جدول ۲ قابل مشاهده است نصب STATCOM و HSFCL باعث افزایش مقدار امپدانس محاسبه شده می شود. مقدار تغییرات امپدانس محاسبه شده، به محل نصب STATCOM و HSFCL مرتبط بوده و با افزایش فاصله بین محل نصب محاسبه شده نیز افزایش می یابد.

زمانی که  $V_{ref} = 1.05$  میباشد STATCOM زمانی که زمانی که  $V_{ref} = 1.05$ 

امپدانس محاسبه شده در شبکه دارای STATCOM و HSFCL (درصد افزایش)	امپدانس محاسبه شده در شبکه دارای HSFCL (درصد افزایش)	امپدانس محاسبه شده در شبکه دارای STATCOM (درصد افزایش)	امپدانس محاسبه شده در شبکه بدون STATCOM HSFCL	محل نصب STATCOM (km)	محل خطا (km)	نوع خطا
10 + j 50 (25/8%)	9+j45 (14/3%)	9+ <i>j</i> 48 (17/4%)	8+ <i>j</i> 40	۴.	٨٠	AG
7 + <i>j</i> 31 (26/8%)	4+ <i>j</i> 27 (15/3%)	5+j29 (17/2%)	4 + <i>j</i> 24	۴.	۵۰	AG
4+ <i>j</i> 21 (31/9%)	3+ <i>j</i> 18 (15/1%)	3+ <i>j</i> 19 (19/2%)	2+ <i>j</i> 16	۲.	٣.	AG
4+j35 (30%)	3+ <i>j</i> 28 (19/8%)	3+j31 (24%)	2+j25	۲.	۶.	ABG
4+j39 (29/6%)	3+j35 (17%)	3+j37 (23/6%)	2+j30	٣٠	۶.	ABG
9+j48 (37.1%)	8+j39 (11.8%)	8.5+ <i>j</i> 41 (17.6%)	6.5 + <i>j</i> 35	۴.	٨٠	ABCG
8+ <i>j</i> 36 (21.2%)	7.5+ <i>j</i> 33 (11.2%)	8+j34 (14.8%)	5+ <i>j</i> 30	٣٠	۶۰	ABCG

جدول(۲) : امپدانس نهایی اندازه گیری شده توسط رله دیستانس در شرایط مختلف

#### ۵-نتیجه گیری

آن اشاره برروی عملکرد حفاظت دیستانس شبکه مورد بررسی قرار ها افزایش گرفته است. نتایج به دست آمده در این مقاله، تاثیر مواردی این مقاله مانند: محل نصب و تنظیمات STATCOM، محل نصب و بان باعث ساختار HSFCL را بر امپدانس اندازه گیری شده، نشان وی دیگر میدهد. از نتایج به دست آمده این مقاله قابل مشاهده است از آسیب که، استفاده از این تجهیزات باعث تغییر مقدار امپدانس ی کند، بر محاسبه شده توسط رله دیستانس شده است. نتیجه افزایش می گذارد. امپدانس محاسبه شده توسط رله دیستانس برهم خوردن برات آنها، تنظیمات سیستم حفاظتی و افزایش امکان عملکرد اشتباه به همراه سیستم حفاظتی خط را همراه خواهد داشت.

در این مقاله تاثیر استفاده از STATCOM و HSFCL

استفاده از STATCOM در کنار مزایای که به آن اشاره شد، دارای معایبی نیز میباشد که از مهمترین آنها افزایش سطح جریان اتصال کوتاه میباشد که از نتایج این مقاله قابل مشاهده میباشد. این افزایش سطح جریان باعث عملکرد اشتباه سیستم حفاظتی میشود. از سوی دیگر استفاده از محدود کننده جریان علاوه بر اینکه از آسیب میلکرد صحیح سیستم حفاظتی نیز تاثیر میگذارد. استفاده از این تجهیزات بدون بررسی شرایط و تاثیرات آنها، استفاده از این تجهیزات بدون بررسی شرایط و تاثیرات آنها، احتمال عملکرد نادرست سیستم حفاظتی را به همراه

#### مراجع

[1] SR. Hosseini, M. Karrari, H. Askarian Abyaneh, "Impedance-based out-of-step protection of generator in the presence of Statcom", Iranian Journal of Electrical and Electronic Engineering, Vol. 15, Issue. 4, December 2019, pp. 524-535.

[2] Y. Liang, C. O. Nwankpa, "A new type of STATCOM based on cascading voltage-source inverters with phase-shifted unipolar SPWM", IEEE transactions on industry applications, Vol. 35, Issue. 5, 1999, pp. 1118–1123.

[3] P. Rao, M. L. Crow, Z. Yang, "STATCOM control for power system voltage control applications", IEEE Transactions on power delivery, Vol. 15, Issue. 4, 2000, pp. 1311–1317.

[4] R. Guan, Y. Xue, XP. Zhang, "Advanced RTDS-based studies of the impact of STATCOM on feeder distance protection", The Journal of Engineering, Vol. 15, October 2018, pp. 1038-1042.

[5] A. Safaei, M. Zolfaghari, M. Gilvanejad, G. B. Gharehpetian, "A survey on fault current limiters: Development and technical aspects", International Journal of Electrical Power & Energy Systems, Vol. 118, June 2020, pp. 105729.

[6] MR. Barzegar-Bafrooei, A. Akbari Foroud, JD. Ashkezari, M. Niasati, "On the advance of SFCL: a comprehensive review", IET Generation, Transmission & Distribution, Vol. 13, Issue. 17, May 2019, pp. 3745-3759.

[8] MR. Barzegar-Bafrooei, A. Akbari Foroud, "Investigation of the performance of distance relay in the presence of saturated iron core SFCL and diode bridge type SFCL", International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol. 29, Issue. 2, February 2019, pp. 2736.

[9] M. Ehsanipour, JS. Moghani, SH. Hosseinian, M. Saberi, "The Impact of Superconducting Fault Current Limiter Locations on Voltage Sag in Power Distribution System", AUT Journal of Electrical Engineering. Vol. 42, Issue. 2, November 2015, pp. 49-60.

[10] MR. Barzegar-Bafrooei, A. Akbari Foroud, "Performance evaluation of distance relay in the presence of hybrid SFCL", IET Science, Measurement & Technology. Vol. 12, Issue. 5, February 2018, pp. 581-593.

[11] J. Yang, L. Zhang, X. Wang, L. Chen, Y. Chen, "The impact of SFCL and SMES integration on the distance relay", Physica C: Superconductivity and its Applications, Vol. 530, 2016, pp. 151-159.

[12] S. Lee, J. Lee, S. Song, J. Yoon, B. Lee, "Novel adaptive distance relay algorithm considering the operation of 154 kV SFCL in Korean power transmission system", Physica C: Superconductivity and its Applications, 2015, PP. 134-139.

[13] M. Firouzi, G. B. Gharehpetian, B. Mozafari, "Bridge-type superconducting fault current limiter effect on distance relay characteristics", International Journal of Electrical Power & Energy Systems. Vol. 68, 2015, pp. 115–122.

[14] B. Li, L. Chao, G. Fengrui, "Application studies on the active SISFCL in electric transmission system and its impact on line distance protection", IEEE Transactions on Applied Superconductivity. Vol. 25, Issue. 2, 2015, pp. 1–9.

[15] S. Lee, J. Lee, S. Song, et al, "Novel adaptive distance relay algorithm considering the operation of 154 kV SFCL in Korean power transmission system", Physica C: Superconductivity and its Applications, Vol. 518, 2015, pp. 134–139.

[16] S. R. Lee, J. J. Lee, J. Yoon, et al, "Protection scheme of a 154 kV SFCL test transmission line at the KEPCO power testing center IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Vol. 27, Issue. 4, 2017, pp. 1–5.

[17] A. Albehadili, A. O. Ikhlas, "Analysis of distance relay performance on shunt FACTS compensated transmission lines", IEEE International Conference on Electro/Information Technology (EIT), 2015, pp. 188-193.

[18] X. Y Zhou, H. F Wang, R. K Aggarwal, P. Beaumont, "The impact of STATCOM on distance relay", 15th PSCC, Liege, Session 19, Paper 4,2005.

[19] R. Dubey, S. R. Samantaray, B. K. Panigrahi, "Adaptive distance protection scheme for shunt-FACTS compensated line connecting wind farm", IET Generation, Transmission & Distribution, Vol. 10, Issue. 1, 2016, pp. 247–256.

[20] R. R. Mishra, P. Tripathi. "Effect of PV-STATCOM on Distance Protection", In 2020 International Conference on Power, Energy, Control and Transmission Systems (ICPECTS), December 2020, pp. 1-6.

[21] E. A. Mohamed, Y. S. Qudaih, Y. Mitani, "Power system stability improvement using STATCOM and RSFCL during grid faults", 2016 19th International Conference on Electrical Machines and Systems (ICEMS), 2016, pp. 1-6.

[22] J. Barati, S. G. Seifossadat, M. Joorabian, "A new adaptive coordination scheme of distance relays in DFIGbased wind farm collector lines and transmission line compensated by STATCOM", International Transactions on Electrical Energy Systems, Vol. 31, Issue. 12, 2021, pp. 13205.

[23] R. S. Thute, H. J. Bahirat, S. A. Khaparde, P. Lubicki, S. Kodle, V. Dabeer, "Line distance protection in the presence of SCFCL", IET Generation, Transmission & Distribution, Vol. 13, Issue. 10, 2019, pp. 1960-1969.

[24] M. Zellagui, A. Chaghi, "Effects of shunt FACTS devices on MHO distance protection setting in 400 kV transmission line", Electrical and Electronic Engineering. Vol. 2, Issue. 3, 2012, pp. 164-169.

[۲۵] مسعود اسماعیلی، مصطفی صدیقی زاده، حسام یارمحمدی، " کنترل یکپارچه ژنراتور القایی، محدودکننده جریان خطا و ذخیرهساز انرژی در مزارع بادی"، نشریه مدلسازی در مهندسی، دوره ۱۶، شماره ۵۵، زمستان ۱۳۹۷، صفحه ۸۷–۱۰۰

[26] M. R. Barzegar-Bafrooei, J. Dehghani-Ashkezari, A. Akbari Foroud, H. Haes Alhelou. "The Classification of FCL: In Fault Current Limiters", Springer, Singapore, 2022, pp. 11-43.

[27] A. K. Singh, N. Singh, A. N. Singh, "Superconducting and non-superconducting fault current limiters: the developmental journey and upcoming prospects". Australian Journal of Electrical and Electronics Engineering, 2022, pp. 1-17.

[28] Alsammak, A. Nasser, S. Janderma, "Enhancement Effects of the STATCOM on the Distance Relay Protection", International Journal of Computer Applications, Vol 975, 2019, pp. 8887.

[29] M. Mbae, N. Nwulu, "Impact of hybrid FACTS devices on the stability of the Kenyan power system", International Journal of Electrical & Computer Engineering, Vol. 12, no. 1, 2022.

[۳۰] زهرا مروج، مجتبی قرجه لو، کاظم مظلومی، " هماهنگی بهینه رلههای دیستانس و اضافه جریان جهتی با استفاده ازالگوریتم ژنتیک"، نشریه مدلسازی در مهندسی، دوره ۱۵، شماره ۴۸، بهار ۱۳۹۶، صفحه ۲۰۱–۲۱۶.